1. pn dioda pri propusnoj polarizaciji naponom 0.6 V vodi struju 0.4 mA. Ako se napon poveća na 0.7 V, struja poraste na 10 mA. Odredi Is i radnu temp. diode.

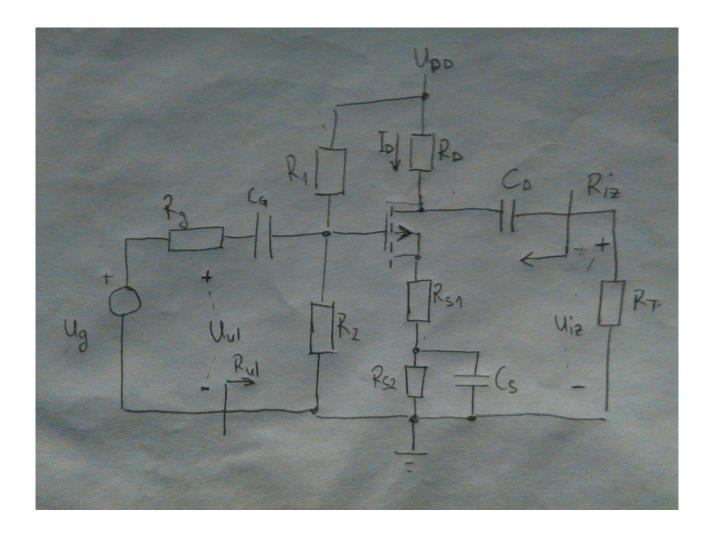
(m=1)

- 2. Za silicijski MOSFET poznate su dvije točke (A i B) koje leže na istoj prijenosnoj karakteristici. Jedna od točaka nalazi se u triodnom području, a druga u području zasićenja. Poznato je: $U_{\mathbf{GSA}} = -0.5V$, $U_{\mathbf{DSA}} = 0.25$ mA, $I_{\mathbf{DA}} = 0.25$ mA, $U_{\mathbf{GSB}} = 2V$, $I_{\mathbf{DB}} = 5$ mA, $\lambda = 0$, zanemariti porast struje odvoda u području zasićenja.
 - a) odredi tip MOSFET-a i tip nosilaca u kanalu
 - b) odredi područje rada tranzistora u točkama A i B
 - c) odredi napon praga Ugso i strujni koeficijent K
 - d) C leži na istoj izlaznoj karakteristici kao i B i U**DSC** = 3V. Odredi područje rada tranzistora i struju odvoda I**DC** u točki C
- 3. Pojačalo zadano je:

 $\begin{array}{l} U_{\text{DD}} = -12 \; V \\ R_{\text{g}} = 500 \; \Omega \\ R_{\text{1}} = 4.3 \; \text{M}\Omega \\ R_{\text{2}} = 2.2 \; \text{M}\Omega \\ R_{\text{D}} = 2 \; \text{k}\Omega \\ R_{\text{S2}} = 200 \; \Omega \\ R_{\text{T}} = 4.7 \; \text{k}\Omega \end{array}$

Parametri $p\sim kanal$. MOSFET-a su $K = -2 \text{ mA/V}^2$ $U_{\text{GSO}} = -1.5 \text{ V}$ i $\lambda = -0.0045 \text{ V}^{-1}$

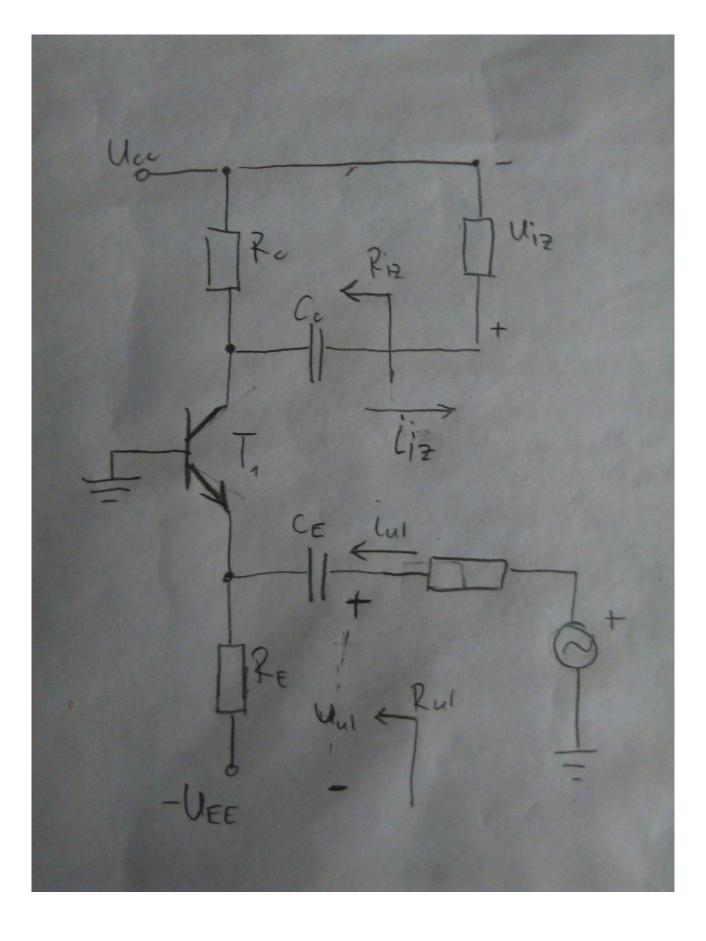
- a) Odrediti vrijednost R_{S1} tako da napon U_{GSQ} iznosi -3 V. Izračunati I_{DQ}, U_{DSQ} te strminu i dinamički otpor u statičkoj radnoj točki. Pri proračunu statičke radne točke zanemariti porast struje odvoda u području zasićenja
- b) Nacrtati nadomjesnu shemu za dinamičku analizu te izvesti izraz i izračunati naponsko pojačanje Av = Uiz/Uul i strminsko pojačanje Gm = uiz/uul, ulazni te izlazni otpor Rul, Riz.



$$\begin{array}{l} \text{4. U}_{\text{CC}} = \text{U}_{\text{EE}} = \text{10 V} \\ \text{R}_{\text{g}} = \text{1 k}\Omega \\ \text{R}_{\text{c}} = \text{3 k}\Omega \\ \text{R}_{\text{E}} = \text{3.6 k}\Omega \\ \text{R}_{\text{T}} = \text{3 k}\Omega \\ \text{B} \approx \text{u}_{\text{fe}} >> \text{1} \\ \text{U}_{\text{Y}} = \text{0.7 V} \\ \text{U}_{\text{T}} = \text{25 mV} \end{array}$$

Zanemarite porast struje kolektora u normalnom (? ne mogu pročitat) aktivnom području.

- a) Odrediti statičku radnu točku (I $_{\text{CQ}},$ U $_{\text{CEQ}})$ i izračunajte strminu g_{m} tranzistora $\mathsf{T_1}$
- b) nacrtajte nadomjesnu shemu pojačala za dinamičku analizu



5. $U_{iz} = ?$ $U_{ul1} = 1 V$ $U_{ul2} = 2 V$ $R_1 = 1 k\Omega$ $R_2 = R_8 = 14.7 k\Omega$ $R_3 = R_4 = 10 k\Omega$ $R_5 = 22 k\Omega$

 $R_6 = 33 \text{ k}\Omega$ $R_7 = 560 \Omega$

